

SWW 1156-7

Hallotron jest elementem półprzewodnikowym, którego działanie oparte jest na zjawisku Halla.

Hallotроны DHX3F i DHX3G są przeznaczone do badania pól i materiałów magnetycznych oraz do kontroli mocy prądu stałego i zmiennego w układach elektronicznych i w automatyce.

Hallotron jest zbudowany z warstwy półprzewodnikowej (InSB) naparowanej na podłożu ceramiczne.

DANE TECHNICZNE

Dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych

Temperatura składowania t_{stg} 243...323 K (-30...+50°C)

Parametry charakterystyczne

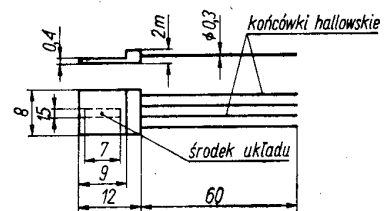
Rezystancja wejściowa R_x 150...500

Rezystancja wyjściowa R_y 150...500

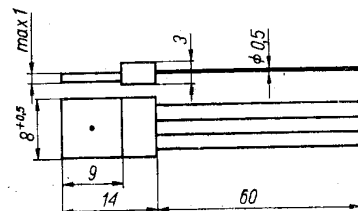
Prąd nominalny sterujący $I_{x,n}$ 20 mA

Napięcie wyjściowe przy $B = 1$ T;
 $I_x = I_{x,n}$ $U_{y,n}$ 0,5...1,5 V
przy $B = 0$;
 $I_x = I_{x,n}$ $U_{y,o}$ 5 V

Temperaturowy współczynnik
— napięcia wyjściowego przy $I_x = I_{x,n}$ β ok. $-1\%/^{\circ}\text{C}$
— rezystywności α $-2,5\%/^{\circ}\text{C}$



Obudowa F — bez zalewy epoksydowej



Obudowa G — z zalewą epoksydową

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR



ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY
PÓLPRZEWODNIKÓW
PRZY INSTYTUCIE
TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ

ul. Młodzieżowa 29/37
87-100 Toruń
Telefon: 27001 Teleks: 86255